

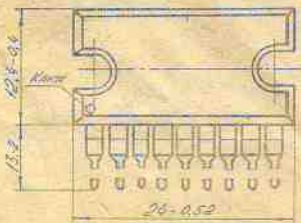


Микросхемы К1021ХАВА,  
К1021ХАББ

### Э Т И К Е Т К А

Микросхемы интегральные К1021ХАВА, К1021ХАББ, выполненные на основе полупроводниковой биполярной технологии с изоляцией  $p-n$  переходов. Предназначены для создания входного сигнала в катушечных отсканирующей системе кадровый размотки в телевизионной аппаратуре.

Схема расположения выводов



Число ножек 10

Обозначения выводов по схеме условны

Таблица назначения выводов

Обозначение вывода	комментарии
01	Вход драйвера 10H
02	Общий вывод 10H
03	Вход системы переключения (SW)
04	Общий вывод выходного каскада 10V0
05	Выход усилителя (P)
06	Напряжение питания выходного каскада (U <sub>out</sub> )
07	Контрольный вывод
08	Выход генератора обратного хода (R <sub>FS</sub> )
09	Напряжение питания (U <sub>in</sub> )

Основные электрические параметры (при температуре 25 ± 10°C)

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Номина			
		K1021XABA		K1021XABP	
		не менее	не более	не менее	не более
Остаточное напряжение по отношению к питанию, В (I <sub>в</sub> = минус 1,5А) (I <sub>в</sub> = минус 1,1А)	U <sub>в</sub> (-)/sat	-	3,0	-	-
Остаточное напряжение по отношению к "земле", В (I <sub>в</sub> = 1,5 А) (I <sub>в</sub> = 1,1 А)	U <sub>в</sub> (-)/sat	-	3,0	-	3,0
Остаточное напряжение генератора обратного хода, В (I <sub>в</sub> = минус 1,5 А) (I <sub>в</sub> = минус 1,1 А)	U <sub>в</sub> (-)/sat	-	3,0	-	3,0
Остаточное напряжение генератора обратного хода, В (I <sub>в</sub> = 1,5 А) (I <sub>в</sub> = 1,1 А)	U <sub>в</sub> (-)/sat	-	2,1	-	2,1
Напряжение пробитывания генератора обратного хода, В (P <sub>max</sub> = 1 кВ ± 0,5%)	U <sub>з-в</sub>	-	3	-	4
Ток потребления (при разомкнутых цепях нагрузки), (U <sub>в</sub> = 25В ± 1%)	I <sub>г</sub>	-	20	-	20

Продолжение

Наименование параметра, единица измерения, режим измерения	Буквенное обозначение	Номина			
		K1021XABA		K1021XABP	
		не менее	не более	не менее	не более
Ток покоя, мА (U <sub>в</sub> = 25В ± 1%)	I <sub>4</sub>	25	65	25	65
Входной ток, мкА (I <sub>в</sub> = 1,5 А, R <sub>в</sub> = 5 Ом ± 1%) (I <sub>в</sub> = 1,1 А, R <sub>в</sub> = 5,6 Ом ± 1%)	I <sub>II</sub>	-	400	-	-
Ток утечки, мкА (U <sub>в</sub> = 8,9 = 13В ± 1%) (U <sub>в</sub> = 2,4 = минус 13 В ± 1%) P <sub>max</sub> = 1кВт ± 0,5%	I <sub>100</sub>	-	50	-	50
Верхняя граничная частота, кГц (R <sub>в</sub> = 1 кОм ± 1%)	F <sub>в</sub>	45	-	45	-
Коэффициент усиления напряжения на частоте 1 кГц, дБ (R <sub>в</sub> = 1 кОм ± 1%)	A <sub>в</sub>	33	-	33	-
Тепловое сопротивление между кристаллом и корпусом, °C/Вт	R <sub>кр-к</sub> -мб	-	4,0	-	4,0
Температура пробитывания схемы тепловой защиты, °C	T <sub>з</sub>	150	192	150	192

Содержание драгоценных металлов в корпусе микросхемы:

золото - 0,0103 г  
 107951.3  
 Содержание цветных металлов в одной микросхеме:  
 медь - 3,5 г

Сведения о гарантии

Микросхема K1021XABA, K1021XABP соответствует техническим условиям АШК.431260.039 ТУ.

Имя ОТК

Имя "Перепроверил, пропаял"

Имя ОТК

DATE

